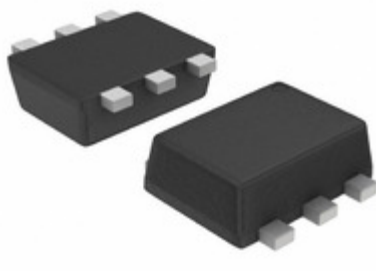
	<b>SSM6J216FE,LF</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SSM6J216FE,LF <b>Hersteller / Marke:</b> Toshiba Semiconductor and Storage <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHANNEL 12V 4.8A ES6 <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SSM6J216FE,LF.pdf</a> <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	SSM6J216FE,LF
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET P-CHANNEL 12V 4.8A ES6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1mA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	ES6
Serie	U-MOSVI
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 3.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Andere Namen	SSM6J216FE,LF(A)
Betriebstemperatur	150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.7nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 4.8A (Ta) 700mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A (Ta)

SSM6J216FE,LF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSM6J216FE,LF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSM6J216FE,LF Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SSM6J216FE,LF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>SSM6J23FE</b> TOSHIBA SSM6J23FE TOSHIBA	 <b>SSM6J214FE(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage X34 SMALL LOW ON RESISTANCE PCH	 <b>SSM6J214FE</b> TOSHIBA SSM6J214FE TOSHIBA	 <b>SSM6J215FE(TE85L,F)</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P CH 20V 3.4A ES6
 <b>SSM6J21TU(TE85L,F)</b> TOSHIBA SSM6J21TU(TE85L,F) TOSHIBA	 <b>SSM6J23FE TE85L</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT-666	 <b>SSM6J21TU(TE85L)</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT363	 <b>SSM6J21TU</b> TOSHIBA SSM6J21TU TOSHIBA

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SSM6J216FE,LF Toshiba Semiconductor and Storage	SSM6J216FE,LF Datenblatt	SSM6J216FE,LF-Datenblätter	SSM6J216FE,LF PDF	Toshiba Semiconductor and Storage SSM6J216FE,LF
SSM6J216FE,LF Electronic	SSM6J216FE,LF-Komponenten	SSM6J216FE,LF-Verteiler	SSM6J216FE,LF-Bild	SSM6J216FE,LF-Teil
SSM6J216FE,LF Preis	SSM6J216FE,LF Hersteller	SSM6J216FE,LF Bild	SSM6J216FE,LF Aktie	SSM6J216FE,LF Inventar
SSM6J216FE,LF Neu	SSM6J216FE,LF Original	SSM6J216FE,LF garantiert	SSM6J216FE,LF RFQ	SSM6J216FE,LF Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited